

т/ф 8(017)200-56-46 email 2005646@tut.by Минск радиодетали электронные компоненты

модули силовые

## SK60GB123 SK75GB12T4T SEMIKRON IGBT МОДУЛЬ МОДУЛИ ПРОДАЖА

17.04.2017 | МИНСК, ОБНОВЛЕНО: 26 ИЮНЯ 2018, 07:09

### SK60GB123 60GB123 SK60

### 60GB123 SK60

модуль

### SK60GB123 60GB123 SK60

SK60GB123 SK75GB12T4T semikron igbt модуль модули продажа

## SK60GB123

### IGBT-модуль SEMITOP 3

Отличительные особенности:

- Компактная конструкция
- Монтаж одним винтом
- Передача тепла и изоляция через DBC-керамику
- N-канальная гомогенная кремниевая структура (NPT IGBT-транзистор)
- Малый хвостовой ток с низкой температурной зависимостью

Области применения:

- Коммутация (не для линейных цепей)
- Инверторы
- Импульсные источники питания
- Источники бесперебойного питания

Предельно-допустимые характеристики (если не указано прочее значение, то полагается  $T_c = 25\text{ °C}$ )

Обозначение	Наименование	Условия снятия характеристики	Значение	Единица измерения
IGBT-транзистор				
$V_{CES}$	напряжение коллектор-эмиттер при замкнутом затворе с эмиттером		1200	В
$V_{GES}$	напряжение затвор-эмиттер при замкнутом коллекторе с эмиттером		$\pm 20$	В
$I_C$	ток коллектора	$T_c = 25\text{ (80) °C}$	58 (40)	А
$I_{CM}$	максимальный ток коллектора	$t_p < 1\text{ мс}, T_s = 25\text{ (80) °C}$	116 (80)	А

$T_j$	температура перехода		- 40 ... + 150	°C
<b>CAL-диод</b>				
$I_F$	прямой ток	$T_c = 25 (80) \text{ } ^\circ\text{C}$	57 (38)	A
$I_{FM} = -I_{CM}$	максимальный повторяющийся прямой ток	$t_{имп} = 1 \text{ мс}$	114 (38)	A
$T_j$	температура перехода		- 40 ... + 150	°C
$T_{stg}$	температура хранения		- 40 ... + 125	°C
$T_{sol}$	температура пайки	выводы, 10 сек.	260	°C
$V_{ISOL}$	напряжение испытания изоляции	действующее значение переменного напряжения, 50Гц, 1 минута/1 секунда	2500/3000	B

Рабочие характеристики (если не указано прочее значение, то полагается  $T_c = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$ )

Обозначение	Наименование	Условия снятия характеристики	мин.	ном.	макс.	Единица измерения
<b>IGBT-транзистор</b>						
$V_{CE(sat)}$	напряжение коллектор-эмиттер насыщения	$I_C = 40 \text{ A}, T_j = 25 (125) \text{ } ^\circ\text{C}$		2,5 (3)		B
$V_{GE(th)}$	пороговое напряжение затвор-эмиттер	$V_{GE} = V_{CE}, I_C = 0,002 \text{ A}$	4,5	5,5	6,5	B
$C_{ies}$	входная емкость при закороченном выходе	$V_{GE} = 0, V_{CE} = 25 \text{ B}, f = 1 \text{ МГц}$		3,5		нФ
$R_{th(j-s)}$	Тепловое сопротивление	для IGBT			0,6	К/Вт
$t_{d(on)}$	длительность задержки включения	при следующих условиях: $V_{CC} = 600 \text{ B}, V_{GE} = \pm 15 \text{ B}, I_C = 40 \text{ A}, T_j = 125 \text{ } ^\circ\text{C}, R_{Gon} = R_{Goff} = 22 \text{ Ом}$ индуктивная нагрузка		40		нс
$t_r$	время нарастания			50		нс
$t_{d(off)}$	длительность задержки выключения			380		нс
$t_f$	время спада			75		нс
$E_{on}+(E_{off})$	рассеиваемая энергия в процессе включения (выключения)			10		мДж
<b>CAL-диод</b>						
$V_F = V_{EC}$	прямое напряжение, равное напряжению на эмиттере-коллекторе	$I_F = 50 \text{ A}; T_j = 25 (125) \text{ } ^\circ\text{C}$		2 (1,8)		B
$V_{(TO)}$	пороговое напряжение	$T_j = (125) \text{ } ^\circ\text{C}$		(1)	(1,2)	B
$r_T$	прямое дифференциальное сопротивление	$T_j = (125) \text{ } ^\circ\text{C}$		(16)	(22)	мОм
$R_{th(j-c)}$	тепловое сопротивление				0,9	К/Вт
$I_{RRM}$	максимальный ток обратного восстановления	при следующих условиях: $I_F = 50 \text{ A}, V_R = 600 \text{ B}, d_{if}/d_t = -800 \text{ A/мкс}, V_{GE} = 0 \text{ B}, T_j = 125 \text{ } ^\circ\text{C}$		40		A
$Q_{rr}$	заряд восстановления			8		мКл
$E_{rr}$	рассеиваемая энергия в процессе обратного восстановления			2		мДж
<b>Механические данные</b>						
$M_1$	монтажный вращающий момент				2,5	Н · м
w	масса			29		грамм
	корпус	SEM1TOP 3		T 27		

$I_C$  — ток коллектора;

$V_{GE}$  — напряжение затвор-эмиттер;

$V_{CE}$  — напряжение коллектор-эмиттер;

$V_{CC}$  — напряжение питания коллектора-эмиттера;

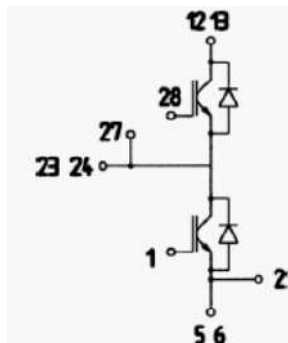
$R_{Gon}$  ( $R_{Goff}$ ) - внешнее последовательное сопротивление с затвором во время включения (выключения);

$I_F$  — номинальный прямой ток.

Внешний вид модулей семейства SEMITOP3:



Схема модуля и расположение выводов SK60GB123:



модуль semikron, igbt, мост диодный Минск +375447584780  
**www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты**  
**email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС**

Мы не работаем с частными (физическими) лицами.

Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту.

**каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото**

# КАТАЛОГ SEMIKRON 2017/2018 МИНСК

## модуль semikron, igbt, мост диодный

купить, продажа

MiniSKiP



SEMTOP



SEMTRANS



SEMIX



SKiM



### Full SiC



### Hybrid SiC



### SKiIP



SEMPACK



10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

SEMTOP



10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

SEMIX

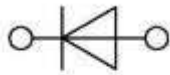


10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

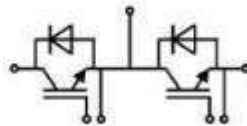
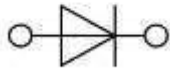
SEMISTART



10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



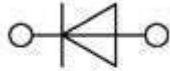
### Power Bridge Rectifiers



### SEMISTACK Classics



### SEMPONT



### SEMITEACH



### SEMIX



### PT 22b3 RoHS

Pulse Transformer

Part Number: 97492890

Manufacturer: SEMIKRON

[datasheet](#)

[Product Details >>](#)

● Current delivery time approx. 10 weeks



### Axial fan 230V 119x38m 150m3/h

Fan

V 230 V

Part Number: 30031061

Manufacturer: SEMIKRON

[datasheet](#)




## Thermal paste P12

Thermal paste

Part Number: 31867700

Manufacturer: SEMIKRON

 [datasheet](#)